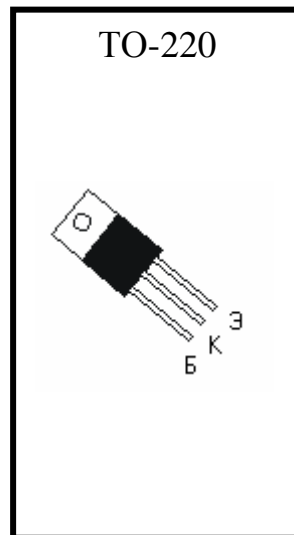


**ЗАО «ЭПЛ»****ПРОИЗВОДСТВО ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ**124460, Москва, Зеленоград, НИИМП, пр. 4806, д. 6, ЗАО «ЭПЛ». Тел./факс (495) 532-81-95, тел.(495) 532-93-36. E-mail: epl@epl.ru, <http://www.epl.ru>**КТ 8284 (А,А1,Б,В)**
АДКБ.432140.169ТУ**Мощный NPN кремниевый транзистор****КТ 8284** – биполярный эпитаксиально-планарный транзистор.**Предназначен**

для коммутации тока в обмотке возбуждения генераторов тока в автотракторных регуляторах напряжения, усилительных и других электронных схемах.

Сочетает достоинство транзисторов Дарлингтона по коэффициенту усиления в широком диапазоне токов коллектора с присущими биполярным транзисторам динамическими характеристиками и низким напряжением насыщения $U_{кэ\text{нас}}$.**Аналог:** КТ 829, КТ 8250 В,Г,Д, Т1Р140, Т1Р141, Т1Р142.
Отечественных аналогов КТ 8284 А1 нет.**Выпускается в двух вариантах исполнения корпуса:**

в пластмассовом корпусном исполнении ТО–220 и в без корпусном исполнении – кристалл для использования в составе гибридных схем.

**Предельно-допустимые режимы эксплуатации.**

Параметры	Обозначение	КТ8284А	КТ8284А1	КТ8284Б	КТ8284В	Ед. Измер.
Напряжение коллектор-база	Uкбо	120	120	160	200	В
Напряжение коллектор-эмиттер	Uкэо	60	60	80	100	В
Напряжение эмиттер-база	Uэбо	8	8	8	8	В
Ток коллектора постоянный	Iк	12	12	12	12	А
Ток коллектора импульсный	Iки	15	15	15	15	А
Ток базы постоянный	Iб	1	1	1	1	А
Рассеиваемая мощность коллектора	Pк max	60	60	60	60	Вт
Температура перехода	Tj	-65 ÷ +150	-65 ÷ +150	-65 ÷ +150	-65 ÷ +150	С°

Основные электрические параметры (Ткорп.=25 С°).

Параметры	Обозначение	Норма	Режим	Гр-па	Ед. измер
Обратный ток коллектор-эмиттер	Iкэо	<50	Uкэ=40В	А,А1	мкА
			Uкэ=60В	Б	мкА
			Uкэ=80В	В	мкА
Обратный ток коллектор-база	Iкбо	<50	Uкб=100В, Rб=∞	А, А1	мкА
			Uкб=120В, Rб=∞	Б	мкА
			Uкб=160В, Rб=∞	В	мкА
Напряжение коллектор-эмиттер граничное	Uкэогр	>60	Iк=10мА, Iб=0	А,А1	В
		>80		Б	В
		>100		В	В
Обратный ток эмиттер-база	Iэбо	≤5	Uэб=5В, Iкэ=0	А,А1, Б,В	мА
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер	Uкэ.нас	≤0,4	Iк=3А, Iб=40мА	А,А1	В
		≤0,6	Iк=3А, Iб=30мА	Б	В
		≤0,8	Iк=3А, Iб=30мА	В	В
Напряжение насыщения база-эмиттер	Uбэ нас	≤1	Iк=3А, Iб=30мА	А,А1, Б,В	В
Статический коэффициент передачи тока	H21э	>150	Iк=5А, Uкэ=1,5В	А,Б,В	
		>300	Iк=0,25А, Uкэ=1,5В		
		>500	Iк=5А, Uкэ=1,5В	А1	

«EPL» Semiconductor Devices Production.124460, Moscow, Zelenograd, NIIMP, «EPL Ltd». Tel./fax +7(495) 532-81-95, tel.+7(495) 532-93-36.
<http://www.epl.ru>, E-mail: epl@epl.ru